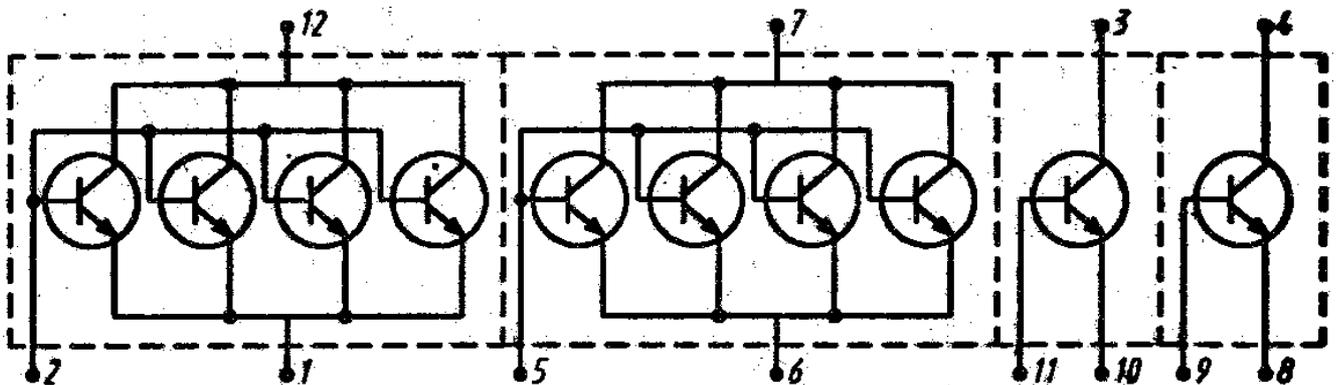
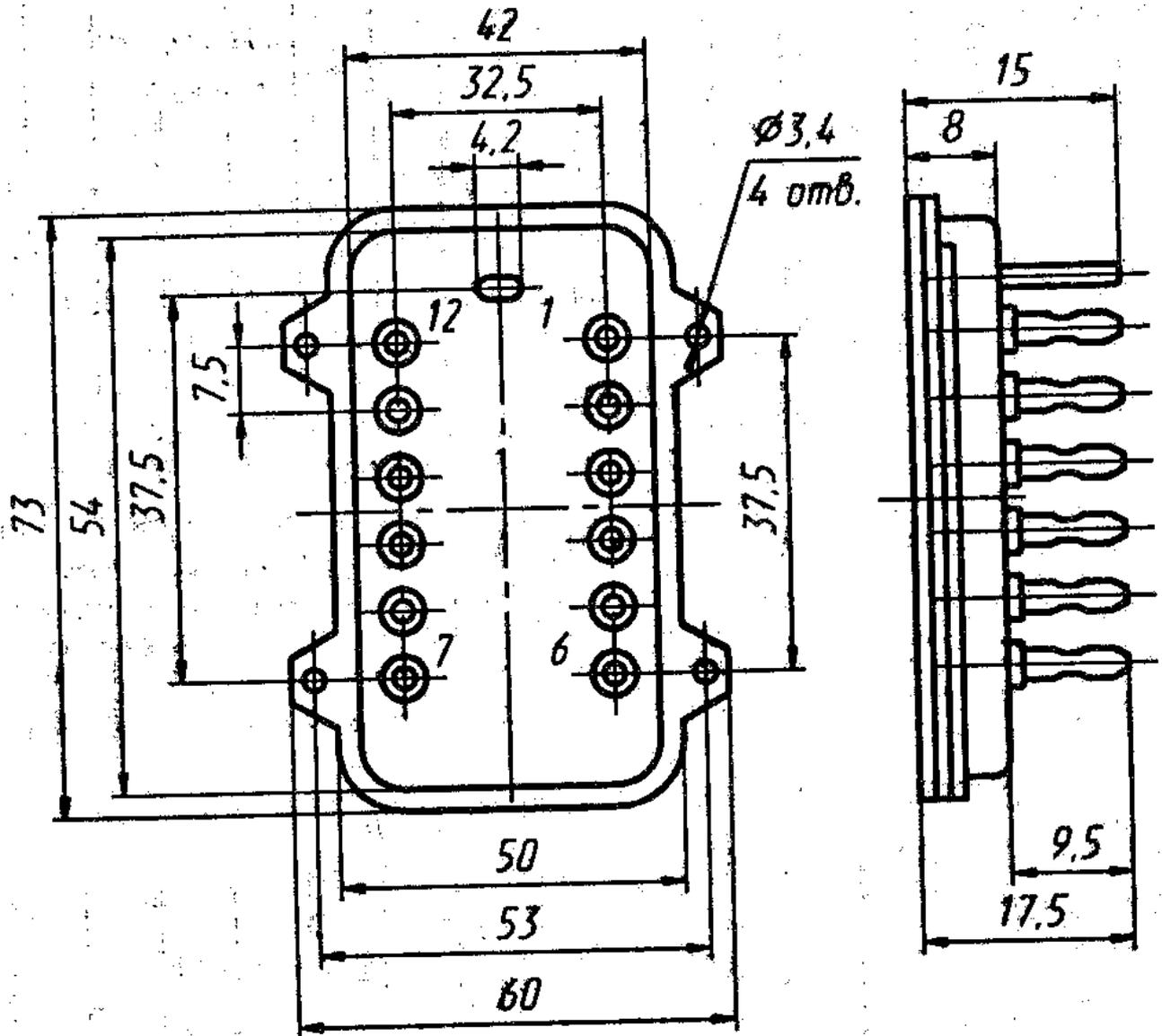


2ТС843А

Транзисторная сборка, состоящая из четырех переключающих кремниевых мезапланарных структур p-p-n транзисторов. Предназначена для применения в источниках вторичного электропитания в системах автоматического управления.

Корпус металлический с жесткими выводами. Масса сборки не более 13 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{эб} = 0$,	
при $I_k = 12$ А для 1-го и 2-го транзисторов, $I_k = 3$ А для 3-го и 4-го транзисторов	
$T = +25$ °С	10...50
$T = +125$ °С	10...150
$T = -60$ °С	6...50*
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер	
1-го транзистора при $I_k = 12$ А, $I_b = 2,4$ А	< 0,6 В
2-го транзистора при $I_k = 12$ А, $I_b = 2,4$ А	< 0,6 В
3-го транзистора при $I_k = 3$ А, $I_b = 0,6$ А	< 0,6 В
4-го транзистора при $I_k = 3$ А, $I_b = 0,6$ А	< 0,6 В
Напряжение насыщения база—эмиттер	
1-го транзистора при $I_k = 12$ А, $I_b = 2,4$ А	< 1,5 В
2-го транзистора при $I_k = 12$ А, $I_b = 2,4$ А	< 1,5 В
3-го транзистора при $I_k = 3$ А, $I_b = 0,6$ А	< 1,5 В
4-го транзистора при $I_k = 3$ А, $I_b = 0,6$ А	< 1,5 В
Время включения	< 1 мкс
Время спада	< 0,7* мкс
Время рассасывания	< 2 мкс
Обратный ток коллектор—эмиттер	
1-го и 2-го транзисторов при $U_{кэ} = 120$ В, $R_{бэ} = 2,5$ Ом	< 80 мА
при $T_k = -60...+25$ °С	< 12 мА
при $T_k = +125$ °С	< 80 мА
3-го и 4-го транзисторов при $U_{кэ} = 120$ В, $R_{бэ} = 10$ Ом	
при $T_k = -60...+25$ °С	< 3 мА
при $T_k = +125$ °С	< 20 мА
Обратный ток эмиттер при $U_{бэ} = 4$ В	
1-го и 2-го транзисторов	0,2 мА
3-го и 4-го транзисторов	0,05 мА

Предельно допустимые значения параметров транзисторов

Постоянное и импульсное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{бэ} = 2,5$ Ом для 1-го и 2-го транзисторов;	
$R_{бэ} = 10$ Ом для 3-го и 4-го транзисторов, $T_k = -60+100$ °С	120 В
Постоянное напряжение база—эмиттер	4 В
Постоянный ток коллектора	
1-го и 2-го транзисторов	12 А
3-го и 4-го транзисторов	3 А
Сумма постоянных токов коллекторов транзисторов при их одновременном включении	
	30 А
Импульсный ток коллектора при $t_i = 10$ мкс	
1-го и 2-го транзисторов	25 А
3-го и 4-го транзисторов	6 А
Сумма импульсных токов коллекторов транзисторов при их одновременном включении	
	62 А
Постоянный ток базы	
1-го и 2-го транзисторов	8 А
3-го и 4-го транзисторов	2 А
Сумма постоянных токов баз транзисторов при их одновременном включении	
	20 А
Постоянная рассеиваемая мощность при $T_k = -60+100$ °С	
1-го и 2-го транзисторов	10 Вт
3-го и 4-го транзисторов	2,5 Вт
сумма постоянных рассеиваемых мощностей транзисторов при их одновременном включении	
	25 Вт
при $T_k = +100+125$ °С	
1-го и 2-го транзисторов	8 Вт
3-го и 4-го транзисторов	2 Вт
сумма постоянных рассеиваемых мощностей транзисторов при их одновременном включении	
	20 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность при $t_i = 10$ мкс	
1-го и 2-го транзисторов	1600 Вт
3-го и 4-го транзисторов	400 Вт

Сумма импульсных рассеиваемых мощностей транзисторов
 при их одновременном включении 4000 Вт
 Температура окружающей среды —60... Тк = +125 °С

Указания по эксплуатации

Пайка транзисторов допускается при температуре +250 °С в течение не более 5 с. Не допускается обрезка, формовка и изгиб выводов.

Зоны возможных положений зависимостей статического коэффициента передачи тока и напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора

